カルコゲナイド合金 Ge2Sb2Te5 におけるナノスケール光誘起相変化

Nano-scale photo-induced phase change in chalcogenide alloy Ge₂Sb₂Te₅

橫浜国大院工¹, 筑波大数理物², 産総研³

谷口 将太朗¹, 片山 郁文¹, 嵐田 雄介¹, 吉岡 克将¹, 吉田 昭二², 重川 秀実², 桑原 正史³, 武田 淳¹

Yokohama National Univ.¹, Univ. Tsukuba², AIST³

S. Yaguchi¹, I. Katayama¹, Y. Arashida¹, K. Yoshioka¹, S. Yoshida², H. Shigekawa², M. Kuwabara³, and J. Takeda¹

E-mail: katayama-ikufumi-bm@ynu.ac.jp, jun@ynu.ac.jp

Ge₂Sb₂Te₅(GST)はその特性を生かして書き換え可能な相変化光ディスクとして広く応用されて いる。光学記録システムにおいて記録状態にはアモルファス相、消去状態には結晶相が対応して おり、これらの相変化は数十ナノ秒のパルス幅を持つレーザーによって熱的に誘起されることが 知られている[1]。一方、近年、超短パルスレーザーの照射により、GSTのアモルファス化を誘起 できることが報告されている。この相変化はサブピコ秒という非常に短いタイムスケールで生じ ることから、電子励起に起因する非熱的相変化過程であると考えられている[2,3]。また、超高速 かつ液相を経ないことから、より高速で安定かつリバーシブルな相変化記録材料への応用が期待 される。このように熱的・非熱的あるいは両者のハイブリッド[4]による様々な相変化モデルが提 唱されているが、未だ完全には GST の相変化ダイナミクスは解明されていない。そこで我々は、 STM の探針-試料間に光パルスを入射することでナノスケールでの GST のアモルファス化を誘起 し、STM や STS を通してその局所的な構造の変化を調べた。

GST 薄膜は HOPG 基板上にスパッタで成膜した。 GST 薄膜の酸化膜はイオン交換水に1分間浸けること で除去した[5]。図 1(a-b)に 1030 nm の光を入射する前 後の STM 原子像を示す。図(c)には光入射前後におけ る dI/dV 曲線を示す。光入射後は STM 像全体が盛り上 がっている。また、dI/dV 曲線から光によってバンド ギャップが広がり、アモルファス化が進んでいること が分かる。さらに、光入射後も原子像が観測されるこ とから、熱的にアモルファス化が誘起されたわけでは ないことが示唆される。詳細については当日報告する。 [1] N. Yamada *et al.*, *Appl. Phys.* **69**, 2849 (1991). [2] M. Konishi *et al.*, *Appl. Opt.* **49**, 3470 (2010). [3] M. Hada *et al.*, *Sci. Rep.* **5**, 13530 (2015). [4] Y. Sanari *et al.*, *Phys. Rev. Lett.* **121**, 165702 (2018).

[5] Z. Zhang et al., Appl. Surf. Sci. 256, 7696 (2010).



FIG. 1 STM images of Ge₂Sb₂Te₅ (a)before and (b)after laser irradiation. (c) dI/dV curves for (a) (blue line) and (b) (red line).